<u>Летняя научная школа</u> <u>"Нанофизика низких температур"</u> Фонд Дмитрия Зимина «ДИНАСТИЯ»

1

## Валерий Рязанов

Заведующий лабораторией сверхпроводимости Института физики твердого тела РАН

Вт. 21 августа 2007, 16:30 - 18:00

Гибридные структуры сверхпроводник-металл

Лекция 2

## План лекции

- Андреевское отражение на FS-границе раздела
- Кросс-андреевское отражение и ко-туннелирование
- π-контакты-джозефсоновские переходы с инверсией разности сверхпроводящих фаз
- Мезоскопический SNS π-контакт
- Осцилляции параметра порядка вблизи SF-границы
- Джозефсоновские SFS π-контакты
- Периодическая зависимость крит тока от толщины F
- Возвратная температурная зависимость крит тока
- Спонтанный магнитный поток в сетках π-контактов
- Возможные приложения π-контактов

# Обменное зонное расщепление. Эффект гигантского магнетосопротивления в туннельных FIF контактах



Подавление андреевского отражения на FS-границе



V.V.Ryazanov .....

k

k<sub>x</sub>

# Измерение спиновой поляризации с помощью SF-контактов



V.V.Ryazanov .....

## Нелокальное кросс-андреевское отражение



#### π-контакты



В кольцах с л-контактами возникают двукратно-вырожденные состояния

V.V.Ryazanov

**▲**Ψ(x)

Ψ

#### Типы π - контактов



## Мезоскопические SNS $\pi$ -контакты

Baselmans et al эксперимент (Nature 397, 43, 1999)



8

#### Неоднородные состояния в магнитных сверхпроводниках

A.I.Buzdin. Rev. Mod. Phys. 77 (2005) 1321 LOFF-состояния: Ларкин, Овчинников (1964) Fulde, Ferrel (1964)

*Однородное состояние:* F=a  $|\Psi|^2 + \gamma |\nabla\Psi|^2 + (b/2) |\Psi|^4$  однородный равновесный параметр порядка  $|\Psi|^2 = -a/b$ 

*Учет парамагнитных эффектов* за счет H,  $E_{ex}$  (распаривание ~ $\mu_B$ H)

При больших Eex/T коэффициент  $\gamma$ -отрицателен, т.е. градиенты пар. порядка выгодны! Необходим учет следующих членов в разложении: F=...+(n(H,T)/2)  $\nabla^2 \Psi$ <sup>2</sup>

Минимизация дает неоднородное состояние с  $\Psi = \Psi_0 \exp(iQr)$ ,

где Q – волновой вектор, *ненулевой импульс пары* (в чистом пределе) a $\Psi$  -  $\gamma \Delta \Psi$ +( $\eta / 2$ )  $\Delta^2 \Psi$ =0 a = -  $\gamma Q^2$  - ( $\eta / 2$ ) $Q^4$ 

а= $\alpha(T_{ci}-T_{cu}) = \gamma^2/(2\eta)$  для максимальной  $T_{ci}$ 

## Спаривание с ненулевым импульсом вблизи SF-границы



10

## Андреевские уровни в SFS переходе



## Эффект близости в SF-структурах



 $\psi(\mathbf{x}) = \psi_0 \exp(-\mathbf{k}\mathbf{x}) = \psi_0 \exp(-\mathbf{x}/\xi_N)$ Время распаривания  $\tau \sim \hbar/k_B T$  $\xi_N \sim (D\tau)^{1/2} \sim (\hbar D/k_B T)^{1/2}$ 



Буздин, Булаевский, Панюков *Письма в ЖЭТФ 35 147 (1982)* Буздин, Вуйчич, Куприянов *ЖЭТФ 101 231 (1992)* 

## Комплексная длина когерентности Период пространственных осцилляций

SN-граница ψ(x) ~ *exp(-k<sub>N</sub>x),* k<sub>N</sub> = 1/ξ<sub>N</sub> -– действительная

Диффузный случай ξ<sub>N</sub> =[ħD/(2πk<sub>B</sub>T)]<sup>1/2</sup> 

 SF-граница

 ψ(x) ~ exp(-k<sub>F</sub>x),

 k<sub>F</sub> - комплексная !

 k<sub>F</sub> = k<sub>F1</sub> + i Q

 Q ~ E<sub>ex</sub> / v<sub>F</sub> (чистый сл.)

 ξ<sub>F</sub> = 1/k<sub>F</sub> - комплексная длина

 когерентности

 $\xi_F = (\hbar D/i E_{ex})^{1/2} (E_{ex} >> k_B T)$ 

 $\psi(x) \sim exp(-x/\xi_F) \sim exp(-x/\xi_{F1}) \cos(-ix/\xi_{F2})$  $\xi_{F1}$  – длина затухания,  $\lambda_{ex} = 2\pi\xi_{F2}$  – период пространственных осцилляций Co, Fe, Ni:  $\xi_{F1} = \xi_{F2} = (\hbar D/E_{ex})^{1/2} < 1 nm$ V.V.Ryazanov ....



## Зависимость критического тока от температуры



Oboznov, Bolginov, Feofanov, Ryazanov, and Buzdin, PRL 96, 197003 (2006)

## SFS слабые связи со слабыми ферромагнетиками





 $x=0.52-0.57; T_{Kюри}=20-150 K; d_F=15-30 nm;$ 

Комплексная длина когерентности в ферромагнетике при  $E_{ex} \sim k_B T$ 





## Джозефсоновские характеристики (II)



После намагничивания



$$I_{\max} = I_c \left| \frac{\sin(\pi \Phi / \Phi_0)}{\pi \Phi / \Phi_0} \right|$$

## Зависимость $\pi$ -0 перехода от величины обменной энергии ферромагнетика

V.R., Oboznov, Prokofiev et al, Journ. Low Temp. Phys. 136, 385 (2004)

Cu<sub>0.48</sub> Ni<sub>0.52</sub>, E<sub>ex1</sub>  $\xi_{F2} = (\hbar D / E_{ov})^{1/2}$ d =27nm  $d_{F,\pi^2} \approx (7/8) \lambda_{ex} = (7/4) \pi (\hbar D/E_{ex})^{1/2}$ 

Сравнение с результатами на SF-, бислоях

 $\mathbf{d}_{\mathrm{F,min}} \approx \lambda_{\mathrm{ex}}/4$ 



V.V.Ryazanov

T (K)

 $\mathbf{E}_{aad} \leq \mathbf{E}_{aad} \leq \mathbf{E}_{aad}$ 

Cu<sub>0.47</sub> Ni<sub>0.53</sub>, E<sub>ex2</sub>

Cu<sub>0.43</sub> Ni<sub>0.57</sub>, E<sub>ex3</sub>

d\_=22nm

=15nm

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1 0.0

1.0

0.8

0,6

0.4

0,2 0.0

3.0

2,5

1.5

1.0 0.5 0.0

 $j_{\,\rm c}\,\,{\rm Acm}^2$ 2,0

, A/cm<sup>2</sup>

j <sub>e</sub> , Akm<sup>2</sup>

## Температурная зависимость толщин 0-π-переходов (эксперимент и теория)

Nb-Cu<sub>0.47</sub>Ni<sub>0.53</sub>-Nb  $d_{F}=9-24 \text{ nm}$   $E_{ex} \sim 850 \text{ K} (T_{Curie}=70 \text{ K})$  ?  $\xi_{F1,2} = \sqrt{\frac{\hbar D}{\sqrt{(\pi k_{B}T)^{2} + E_{ex}^{2}} \pm \pi k_{B}T}} \simeq \sqrt{\frac{\hbar D}{E_{ex}}} (1 \mp \frac{\pi k_{B}T}{2E_{ex}})$ 

"Температурно-зависящее" рассеяние с переворотом спина Buzdin in Oboznov et al, Phys. Rev. Lett. 96, (2006).

$$1/\xi_{F1} = k_1 = \frac{1}{\xi_F} \sqrt{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{E_{ex}} + \frac{\hbar}{E_{ex}\tau_s}\right)^2} + \frac{\omega}{E_{ex}} + \frac{\hbar}{E_{ex}\tau_s}}} \qquad \xi_{F1} \approx 1.37 \text{ nm}$$
$$1/\xi_{F2} = k_2 = \frac{1}{\xi_F} \sqrt{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{E_{ex}} + \frac{\hbar}{E_{ex}\tau_s}\right)^2} - \left(\frac{\omega}{E_{ex}} + \frac{\hbar}{E_{ex}\tau_s}\right)}} \qquad \xi_{F2} \approx 3.5 \text{ nm}$$

Прозрачная

$$\begin{pmatrix} \omega + iE_{ex} + \frac{\hbar\cos\Theta}{\tau_s} \end{pmatrix} \sin\Theta - \frac{\hbar D}{2} \frac{\partial^2 \Theta}{\partial x^2} = 0$$
 Эффективная spin-flip  
G = cos  $\Theta(T)$ ; F = sin  $\Theta(T)$  Эффективная spin-flip  
частота  $\Gamma(T) = \cos \Theta(T)/\tau_s$ ;

SF- граница

## Технология приготовления SFS переходов

#### Послойная технология

1: Осаждение нижнего Nb слоя



3: Вскрытие окна в SiO



4: Осаждение верхнего Nb слоя



 $5\mu m \times 5\mu m - 50\mu m \times 50\mu m$ 

## 1: Осаждение Nb-CuNi-Nb трехслойки



Трехслойная технология

2: Ионное травление Nb+CuNi, осаждение SiO, lift-off



3: Осаждение верхнего Nb слоя



## $10\mu m \times 10\mu m$



# Прямое наблюдение спонтанного магнитного потока в джозефсоновских сетках с $\pi$ -контактами

совместно с С.Фроловым и Д.Ван Харлингеном (Урбана, США)



Полностью фрустрированная джозефсоновская сетка



## Джозефсоновские сетки



unfrustrated



fully-frustrated



checkerboard-frustrated





V.V.Ryazanov .....fully-frustrated....

2 x 2

6 x 6

## Визуализация спонтанного потока в сетках $\pi$ -контактов

Frolov, Stoutimore, Crane, Van Harlingen, Oboznov, V.R. et al, accepted to Nature Physics



## Фазово-чувствительные эксперименты Интерферометры



## Комплементарная джозефсоновская логика

E. Terziogu, M.R. Beasley, IEEE Trans. On Appl. Supercond. 8, 48 (1998)  $j = j_c \sin(\varphi + \pi)$ 





V.V.Ryazanov

 $f_{\text{model}}^{25}$ 

## RSFQ-логика, использующая фазовые *π*-инверторы

A.V.Ustinov, V.K.Kaplunenko. Journ. Appl. Phys. 94, 5405 (2003) **RSFQ-**логика: Rapid Single Flux Quantum logic  $L_J = \Phi_0 / (2\pi I_c)$  $\tau \sim 1 / (I_c \mathbf{R})$ Традиционная RSFQ-ячейка in  $\pi$ -RSFQ -ячейка  $LI_c > \Phi_{\theta}$  $L \rightarrow 0$ out 1 out 2 Fluxon memorizing cell π-RSFQ –триггер

#### Прямое измерение токо-фазового соотношения

Frolov, Van Harlingen, Oboznov, Bolginov, V.R., PR B 70, 144505 (2004).

dc SQUID метод: J.R. Waldram et al., Rev. Phys. Appl. 10, 7 (1975)



## Токо-фазовый эксперимент



$$\Phi_e = L I \qquad \varphi = 2\pi \Phi/\Phi_0$$
$$I = \Phi/L + I_c \sin(2\pi \Phi/\Phi_0)$$



## Инверсия токо-фазового соотношения



V.V.Ryazanov

II

#### Nb-Cu<sub>0.47</sub>Ni<sub>0.53</sub>-Nb $I=I_{c1}\sin\varphi+I_{c2}\sin(2\varphi)+...$ $10 \text{ x} 10 \text{ } \mu\text{m}^2$ CNT-10(1) T = 3.24 K v = 7 MHz T=3.24 K step height = 14.49 nV 30/01/07 1.6 ۷, vΦ<sub>0</sub> 0 π 1.4 d<sub>F</sub>=7.2 nm 1.2 c, mA 1.0 0.2 0.6 0.8 1.0 I, mA 0.8 0.6 CNT-10(1) CNT-10(1) 30/01/07 T = 3.11 K = 7 MHz T=3.11 K T\_= 3.11 K 0.4 step heiaht = 14.49 nV 30/01/07 $T_{\pi} = 3.1$ νΦ > 0.2 0.0 3.3 3.4 3.2 3.5 2.8 2.9 3.1 3.6 3.7 3.0 Т, К 0.8 0.4 0.6 l mA $I=I_{c2}sin(2\phi); I_{c1}=0;$ CNT-10(1) $V_{\varphi} = \frac{\hbar}{2e} \frac{d\varphi}{dt} = \frac{\hbar}{2e} 2\pi f = \Phi_0 f$ T = 3.05 K I<sub>s</sub>† = 7 MHz step height = 14.49 n∨ 30/01/07 νΦ T=3.06 K $V_{2\varphi} = \frac{\hbar}{2e} \frac{d\varphi}{dt} = \frac{\hbar}{2e} \pi f = \frac{\Phi_0}{2} f = \frac{V_{\varphi}^2}{2}$ () $2\pi$ 0.2 04 0.6 0.8 1.0 I, mA

V.V.Ryazanov .....

## Обнаружение 2ф-компоненты (sin(2ф)). Ступени Шапиро

## Ф<sub>0</sub> /2-периодичность Фраунгоферовской зависимости



